

Содержание

- **Обзоры**
 - Баграев Н.Т., Клячкин Л.Е., Кузьмин Р.В., Маляренко А.М., Машков В.А.**
Инфракрасное излучение из кремниевых наноструктур, сильно легированных бором 289
- **Электронные свойства полупроводников**
 - Тагиров В.И., Агамалиев З.А., Садыхова С.Р., Гулиев А.Ф., Гахраманов Н.Ф.**
Об энергетических уровнях серебра в твердых растворах Ge-Si 304
 - Алиев С.А., Зульфигаров Э.И., Селим-заде Р.И.**
Особенности температурной зависимости концентрации электронов проводимости в узкощелевом и бсщелевом состоянии $Cd_xHg_{1-x}Te$ 308
 - Алиев Ф.Ф., Гасанов Г.А.**
Влияние самария на термоэлектрическую добротность твердых растворов $Sm_xPb_{1-x}Te$ 313
 - Беляев А.Е., Клюй Н.И., Конакова Р.В., Лукьянов А.Н., Данильченко Б.А., Свешников Ю.Н., Клюй А.Н.**
Исследование методом электроотражения влияния γ -облучения на оптические свойства эпитаксиальных пленок GaN 317
 - Третьяк А.П., Давидюк Г.Е., Божко В.В., Булатецкая Л.В., Парасюк О.В.**
Влияние структурных дефектов технологического происхождения на оптические и фотоэлектрические свойства твердого раствора $AgCd_{2-x}Mn_xGaSe_4$ 321
 - Грушка О.Г., Маслюк В.Т., Чупыра С.М., Мысляк О.М., Биличук С.В., Заболоцкий И.И.**
Влияние облучения электронами на электрофизические параметры $Hg_3In_2Te_6$ 327
 - Курова И.А., Ормонт Н.Н.**
Об особенностях процессов рекомбинации в слоистых пленках α -Si:H 330
 - Тагиев Б.Г., Тагиев О.В., Асадуллаева С.Г., Эйюбов Г.И.**
Вольт-амперные характеристики монокристаллов соединения $MnGa_2Se_4$ 334
- **Спектроскопия, взаимодействие с излучениями**
 - Власенко Н.А., Сопинский Н.В., Гуле Е.Г., Стрельчук В.В., Олексенко П.Ф., Велигура Л.И., Николенко А.С., Мухльо М.А.**
Влияние легирования фторидом эрбия на фотолюминесценцию пленок SiO_2 338
- **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**
 - Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Саченко А.В., Шерemet В.Н., Виноградов А.О.**
Температурная зависимость контактного сопротивления омических контактов Au-Ti-Pd₂Si-n⁺-Si, подвергнутых микроволновому облучению 344
 - Саченко А.В., Беляев А.Е., Бобыль А.В., Болтовец Н.В., Иванов В.Н., Капитанчук Л.М., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Миленин В.В., Новицкий С.В., Саксеев Д.А., Тарасов И.С., Шерemet В.Н., Яговкина М.А.**
Температурная зависимость контактного сопротивления омических контактов на основе соединений $A^{III}B^V$ с высокой плотностью дислокаций 348
- **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**
 - Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Нятыга В.В., Кудринский З.Р., Литвин О.С.**
Морфология поверхности и электрические свойства гибридных структур, сформированных на основе слоистого полупроводника с наноразмерными сегнетоэлектрическими включениями Au/Ni(C)/n-Ga₂O₃/p-GaSe(KNO₃) 356
 - Жигунов Д.М., Швыдун Н.В., Емельянов А.В., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К., Семиногов В.Н.**
Фотолюминесцентное исследование структурной эволюции аморфных и кристаллических нанокластеров кремния при термическом отжиге слоев субоксида кремния различной стехиометрии 369
 - Семинов С.В., Шерстюк Н.Э., Мишина Е.Д., Герман К., Кулюк Л., Расинг Т., Пенг Л.-Х.**
Картирование усиления двухфотонной люминесценции в микроструктурах оксида цинка 376
- **Углеродные системы**
 - Давыдов С.Ю.**
Задача о димере, адсорбированном на однолистном графене 379
- **Физика полупроводниковых приборов**
 - Смирнова И.П., Марков Л.К., Павлюченко А.С., Кукушкин М.В.**
AlGaInN-светодиоды с прозрачным p-контактом на основе тонких пленок ИТО 384
 - Косяченко Л.А., Склярчук В.М., Мельничук С.В., Масляничук О.Л., Грушко Е.В., Склярчук О.В.**
Влияние концентрации нескомпенсированных примесей на свойства детекторов рентгеновского и γ -излучения на основе CdTe 389

Gassoumi M., Grimbert B., Gaquiere C., Maaref H.

Evidence of surface states for AlGaN/GaN/SiC HEMTs passivated Si₃N₄ by CDLTS 396

Kazerouni Iman Abaspor, Hosseini Seyed Ebrahim

An analytical gate tunneling current model for MOSFETs . . . 400

Газизов И.М., Залетин В.М., Кукушкин В.М., Кузнецов М.С., Лисицкий И.С.

Кинетика отклика тока детекторов TlBr в поле γ -излучения высокой мощности дозы 405

Иванов П.А., Грехов И.В., Потапов А.С., Коньков О.И., Ильинская Н.Д., Самсонова Т.П., Kogol'kov O., Sleptsuk N.

Токи утечки в 4H-SiC-диодах Шоттки с интегрированной шоттки-(*p-n*-структурой) 411

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Фоминский В.Ю., Григорьев С.Н., Романов Р.И., Зуев В.В., Григорьев В.В.

Свойства тонких пленок оксида вольфрама, формируемых методами ионно-плазменного и лазерного осаждения для детектора водорода на основе структуры MOSiC . . . 416

Зуев Д.А., Лотин А.А., Новодворский О.А., Лебедев Ф.В., Храмова О.Д., Петухов И.А., Путилин Ф.Н., Шатохин А.Н., Румянцева М.Н., Гаськов А.М.

Импульсное лазерное осаждение тонких пленок ГЮ и их характеристики 425

● **Персоналии**

Роберт Арнольдович Сурис

(к 75-летию со дня рождения) 430